

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Dispositivos transistorizados avançados

Fórmulas

[Calculadoras!](#)[Exemplos!](#)[Conversões!](#)

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**

Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Lista de 20 Dispositivos transistorizados avançados Fórmulas

Dispositivos transistorizados avançados ↗

FET ↗

1) Capacitância da fonte de porta do FET ↗

fx $C_{gs(fet)} = \frac{T_{gs-off(fet)}}{\left(1 - \left(\frac{V_{ds(fet)}}{\Psi_0(fet)}\right)\right)^{\frac{1}{3}}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $6.805694F = \frac{2.234s}{\left(1 - \left(\frac{4.8V}{4.976V}\right)\right)^{\frac{1}{3}}}$

2) Capacitância de drenagem do portão do FET ↗

fx $C_{gd(fet)} = \frac{T_{gd-off(fet)}}{\left(1 - \frac{V_{gd(fet)}}{\Psi_0(fet)}\right)^{\frac{1}{3}}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $6.475557F = \frac{6.47s}{\left(1 - \frac{0.0128V}{4.976V}\right)^{\frac{1}{3}}}$

3) Corrente de drenagem da região ôhmica do FET ↗

fx $I_{d(fet)} = G_{o(fet)} \cdot \left(V_{ds(fet)} + \frac{3}{2} \cdot \frac{(\Psi_0(fet) + V_{ds(fet)} - V_{ds(fet)})^{\frac{3}{2}} - (\Psi_0(fet) + V_{ds(fet)})^{\frac{3}{2}}}{(\Psi_0(fet) + V_{off(fet)})^{\frac{1}{2}}} \right)$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.305501mA = 0.24mS \cdot \left(4.8V + \frac{3}{2} \cdot \frac{(4.976V + 4.8V - 4.8V)^{\frac{3}{2}} - (4.976V + 4.8V)^{\frac{3}{2}}}{(4.976V + 63.56V)^{\frac{1}{2}}} \right)$

4) Corrente de drenagem do FET ↗

fx $I_{d(fet)} = I_{dss(fet)} \cdot \left(1 - \frac{V_{ds(fet)}}{V_{cut-off(fet)}} \right)^2$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.301384mA = 0.69mA \cdot \left(1 - \frac{4.8V}{2.89V} \right)^2$



5) Corte a tensão do FET ↗

$$\text{fx } V_{\text{off(fet)}} = V_{\text{ds-off(fet)}} - V_{\text{ds(fet)}}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 63.36V = 68.16V - 4.8V$$

6) Ganho de tensão do FET ↗

$$\text{fx } A_v(\text{fet}) = -G_m(\text{fet}) \cdot R_d(\text{fet})$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } -0.0064V = -0.02mS \cdot 0.32k\Omega$$

7) Tensão da fonte de drenagem do FET ↗

$$\text{fx } V_{\text{ds(fet)}} = V_{\text{dd(fet)}} - I_{\text{d(fet)}} \cdot (R_d(\text{fet}) + R_s(\text{fet}))$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 4.8407V = 5V - 0.3mA \cdot (0.32k\Omega + 0.211k\Omega)$$

8) Transcondutância de FET ↗

$$\text{fx } G_m(\text{fet}) = \frac{2 \cdot I_{\text{dss}(\text{fet})}}{V_{\text{off}(\text{fet})}} \cdot \left(1 - \frac{V_{\text{ds}(\text{fet})}}{V_{\text{off}(\text{fet})}} \right)$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 0.020072mS = \frac{2 \cdot 0.69mA}{63.56V} \cdot \left(1 - \frac{4.8V}{63.56V} \right)$$

IGBT ↗

9) Capacitância de entrada do IGBT ↗

$$\text{fx } C_{\text{in(igbt)}} = C_{(\text{g-e})(\text{igbt})} + C_{(\text{g-c})(\text{igbt})}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 5.76F = 0.21F + 5.55F$$

10) Corrente do Emissor do IGBT ↗

$$\text{fx } I_e(\text{igbt}) = I_h(\text{igbt}) + i_e(\text{igbt})$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 12.523mA = 12.2mA + 0.323mA$$



11) Corrente Nominal Contínua do Coletor do IGBT ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$fx \quad i_{f(igbt)} = \frac{-V_{ce(igbt)} + \sqrt{(V_{ce(igbt)})^2 + 4 \cdot R_{ce(igbt)} \cdot \left(\frac{T_{jmax(igbt)} - T_{c(igbt)}}{R_{th(jc)}(igbt)} \right)}}{2 \cdot R_{ce(igbt)}}$$

$$ex \quad 1.691553mA = \frac{-21.56V + \sqrt{(21.56V)^2 + 4 \cdot 12.546k\Omega \cdot \left(\frac{283^{\circ}C - 250^{\circ}C}{0.456k\Omega} \right)}}{2 \cdot 12.546k\Omega}$$

12) Dissipação Máxima de Potência em IGBT ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$fx \quad P_{max(igbt)} = \frac{T_{jmax(igbt)}}{\theta_{j-c}(igbt)}$$

$$ex \quad 110.2597W = \frac{283^{\circ}C}{289^{\circ}}$$

13) Queda de tensão no IGBT no estado ON ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$fx \quad V_{ON(igbt)} = i_{f(igbt)} \cdot R_{ch(igbt)} + i_{f(igbt)} \cdot R_{d(igbt)} + V_{j1(igbt)}$$

$$ex \quad 20.2533V = 1.69mA \cdot 10.59k\Omega + 1.69mA \cdot 0.98k\Omega + 0.7V$$

14) Tempo de desligamento do IGBT ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$fx \quad T_{off(igbt)} = T_{dl(igbt)} + t_{f1(igbt)} + t_{f2(igbt)}$$

$$ex \quad 3.472s = 1.15s + 1.67s + 0.652s$$

15) Tensão de ruptura de polarização direta do IGBT ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$fx \quad BV_{soa(igbt)} = \frac{5.34 \cdot 10^{13}}{(N_p(igbt))^{\frac{3}{4}}}$$

$$ex \quad 37.53628V = \frac{5.34 \cdot 10^{13}}{(16e15C)^{\frac{3}{4}}}$$

16) Tensão de saturação do IGBT ↗

[Abrir Calculadora](#)

$$fx \quad V_{c-e(sat)(igbt)} = V_{B-E(pnp)(igbt)} + I_d(igbt) \cdot (R_s(igbt) + R_{ch(igbt)})$$

$$ex \quad 1222.25V = 2.15V + 105mA \cdot (1.03k\Omega + 10.59k\Omega)$$



TRIAC**17) Corrente de carga RMS do TRIAC**

$$\text{fx } I_{\text{rms(triac)}} = \frac{I_{\text{peak(triac)}}}{2}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 0.09\text{mA} = \frac{0.18\text{mA}}{2}$$

18) Corrente média de carga do TRIAC

$$\text{fx } I_{\text{avg(triac)}} = \frac{2 \cdot \sqrt{2} \cdot I_{\text{rms(triac)}}}{\pi}$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 0.081028\text{mA} = \frac{2 \cdot \sqrt{2} \cdot 0.09\text{mA}}{\pi}$$

19) Dissipação de energia do TRIAC

$$\text{fx } P_{\text{max(triac)}} = V_{\text{knee(triac)}} \cdot I_{\text{avg(triac)}} + R_s(\text{triac}) \cdot I_{\text{rms(triac)}}^2$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 0.294215\text{mW} = 3.63\text{V} \cdot 0.081028\text{mA} + 0.0103\text{k}\Omega \cdot (0.09\text{mA})^2$$

20) Temperatura máxima de junção do TRIAC

$$\text{fx } T_{j\text{max(triac)}} = T_a(\text{triac}) + P_{(\text{triac})} \cdot R_{\text{th(j-a)}}(\text{triac})$$

[Abrir Calculadora](#)

$$\text{ex } 196.12^\circ\text{C} = 102.4^\circ\text{C} + 0.66\text{W} \cdot 0.142\text{k}\Omega$$



Variáveis Usadas

- $A_{v(fet)}$ Ganho de tensão FET (Volt)
- $BV_{soa(igbt)}$ Tensão de ruptura SOA IGBT (Volt)
- $C_{(g-c)(igbt)}$ Porta para capacitância do coletor (IGBT) (Farad)
- $C_{(g-e)(igbt)}$ Capacitância de porta para emissor (IGBT) (Farad)
- $C_{gd(fet)}$ Capacitância de drenagem da porta FET (Farad)
- $C_{gs(fet)}$ FET de capacitância da fonte de porta (Farad)
- $C_{in(igbt)}$ Capacitância de entrada (IGBT) (Farad)
- $G_m(fet)$ FET de transcondutância direta (Millisiemens)
- $G_o(fet)$ FET de condutância do canal (Millisiemens)
- $I_{avg(triac)}$ Corrente média de carga TRIAC (Miliampères)
- $I_d(fet)$ Drenar FET atual (Miliampères)
- $I_d(igbt)$ Corrente de drenagem (IGBT) (Miliampères)
- $I_{dss(fet)}$ Corrente de drenagem de polarização zero (Miliampères)
- $I_e(igbt)$ Corrente Eletrônica (IGBT) (Miliampères)
- $I_{e(igbt)}$ Corrente do emissor (IGBT) (Miliampères)
- $I_f(igbt)$ Corrente direta (IGBT) (Miliampères)
- $I_h(igbt)$ Corrente do furo (IGBT) (Miliampères)
- $I_{peak(triac)}$ Corrente de pico TRIAC (Miliampères)
- $I_{rms(triac)}$ TRIAC atual RMS (Miliampères)
- $N_p(igbt)$ Carga Positiva Líquida (IGBT) (Coulomb)
- $P_{(triac)}$ Potência de Dissipação TRIAC (Watt)
- $P_{max(igbt)}$ Dissipação Máxima de Potência (IGBT) (Watt)
- $P_{max(triac)}$ Dissipação Máxima de Potência TRIAC (Miliwatt)
- $R_{ce(igbt)}$ Resistência do Coletor e Emissor (IGBT) (Quilohm)
- $R_{ch(igbt)}$ Resistência do Canal N (IGBT) (Quilohm)
- $R_d(fet)$ FET de resistência à drenagem (Quilohm)
- $R_d(igbt)$ Resistência à Deriva (IGBT) (Quilohm)
- $R_s(fet)$ FET de resistência de fonte (Quilohm)
- $R_s(igbt)$ Resistência à condutividade IGBT (Quilohm)
- $R_s(triac)$ Resistência à Condutividade TRIAC (Quilohm)
- $R_{th(j-a)(triac)}$ Junção para Resistência Térmica Ambiente TRIAC (Quilohm)



- $R_{th(jc)}$ (igbt) Resistência Térmica (IGBT) (Quilohm)
- T_a (triac) TRIAC de temperatura ambiente (Celsius)
- T_c (igbt) Temperatura da caixa IGBT (Celsius)
- T_{dl} (igbt) Tempo de atraso (IGBT) (Segundo)
- t_{f1} (igbt) Tempo de queda inicial (IGBT) (Segundo)
- t_{f2} (igbt) Tempo Final de Queda (IGBT) (Segundo)
- $T_{gd-off(fet)}$ Tempo de desligamento da capacitância de drenagem da porta FET (Segundo)
- $T_{gs-off(fet)}$ Tempo de desligamento da capacitância da fonte da porta FET (Segundo)
- $T_{jmax(igbt)}$ Junção Operacional Máxima (IGBT) (Celsius)
- $T_{jmax(triac)}$ Junção operacional máxima TRIAC (Celsius)
- $T_{off(igbt)}$ Tempo de desligamento (IGBT) (Segundo)
- $V_{B-E(pnp)}$ (igbt) Tensão base do emissor PNP IGBT (Volt)
- V_{ce} (igbt) Tensão Total do Coletor e Emissor (IGBT) (Volt)
- $V_{c-e(sat)}$ (igbt) Tensão de saturação do coletor para emissor (IGBT) (Volt)
- $V_{cut-off(fet)}$ Tensão de corte FET (Volt)
- $V_{dd(fet)}$ Tensão de alimentação no dreno FET (Volt)
- $V_{ds(fet)}$ Tensão da fonte de drenagem FET (Volt)
- $V_{ds-off(fet)}$ Aperte a tensão da fonte de drenagem FET (Volt)
- $V_{gd(fet)}$ Porta para Drenar Tensão FET (Volt)
- V_{j1} (igbt) Junção Pn de Tensão 1 (IGBT) (Volt)
- V_{knee} (triac) Tensão do Joelho TRIAC (Volt)
- $V_{off(fet)}$ Aperte a tensão (Volt)
- V_{ON} (igbt) Queda de tensão no estágio (IGBT) (Volt)
- θ_{j-c} (igbt) Junção ao Ângulo da Caixa (IGBT) (Grau)
- Ψ_0 (fet) Potencial de superfície FET (Volt)



Constantes, Funções, Medidas usadas

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Constante de Arquimedes

- **Função:** sqrt, sqrt(Number)

Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.

- **Medição:** Tempo in Segundo (s)

Tempo Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Corrente elétrica in Miliampères (mA)

Corrente elétrica Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Temperatura in Celsius (°C)

Temperatura Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Carga elétrica in Coulomb (C)

Carga elétrica Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Poder in Watt (W), Miliwatt (mW)

Poder Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Ângulo in Grau (°)

Ângulo Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Capacitância in Farad (F)

Capacitância Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Resistência Elétrica in Quilohm (kΩ)

Resistência Elétrica Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Condutância Elétrica in Millisiemens (mS)

Condutância Elétrica Conversão de unidades ↗

- **Medição:** Potencial elétrico in Volt (V)

Potencial elétrico Conversão de unidades ↗



Verifique outras listas de fórmulas

- Dispositivos transistorizados avançados Fórmulas ↗
- Dispositivos transistorizados básicos Fórmulas ↗
- Helicópteros Fórmulas ↗
- Retificadores Controlados Fórmulas ↗
- Unidades CC Fórmulas ↗
- Inversores Fórmulas ↗
- Retificador controlado por silicone Fórmulas ↗
- Regulador de comutação Fórmulas ↗
- Retificadores Não Controlados Fórmulas ↗

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/15/2024 | 5:04:19 AM UTC

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)

